

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-273584

(43)Date of publication of application : 22.10.1993

(51)Int.CI.

G02F 1/136 G02F 1/133 G09F 9/30 G09G 3/36 H01L 27/12 H01L 29/784

(21)Application number: 04-068601

1 000

(71)Applicant : FUJITSU LTD

(22)Date of filing: 26.03.1992

(72)Inventor: TANUMA SEIJI

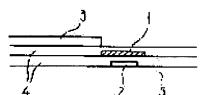
KATO SHOICHI

WAKABAYASHI TAKASHI

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY PANEL

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a thin film transistor liquid crystal display panel of superior display quality by removing disorder of the uniformity of an array of liquid crystal molecules on pixel electrodes which is caused with a gate-OFF voltage and the voltage of pixel electrodes to cause a pixel defect and then a defect in display quality. CONSTITUTION: Individual bus lines 1 which are parallel to gate bus lines are provided on the gate bus lines across an insulator 4 and a shield electrode which holds the potential of the bus lines 1 constant at the time of driving is provided. Further, the pixel electrodes are extended to provide a part where the pixel electrode overlaps with the gate bus lines 2 on both sides of the pixel electrode across an insulating film.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

12.03.1999

[Date of sending the examiner's decision of

31.10.2000

rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平5-273584

(43)公開日 平成5年(1993)10月22日

(51)Int.Cl. ⁵ G 0 2 F	1/136 1/133 9/30	識別記号 5 0 0 5 5 0 3 3 8	庁内整理番号 9018-2K 7820-2K 6447-5G	FΙ	技術表示箇所
GOSF	3/36	336	7319-5G		
	-,		9056-4M	H01L	29/ 78 3 1 1 A
				審査請求 未請求	請求項の数3(全 5 頁) 最終頁に続く
(21)出顧番号	}	特願平4-68601		(71)出願人	
			_		富士通株式会社
(22)出願日		平成4年(1992)3	月26日		神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
				(72)発明者	
					神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
				(200) 74 200 444	富士通株式会社内
				(72)発明者	
					神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
				(a=) 74 mm at	富士通株式会社内
				(72)発明者	
					神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
				5	富士通株式会社内
				(74)代理人	弁理士 井桁 貞一

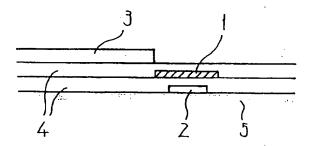
(54)【発明の名称】 液晶表示パネル

(57)【要約】

【目的】薄膜トランジスタ液晶パネルにおいて、画素欠陥となって表示品質不良の原因となる、ゲートオフ電圧と画素電極間の電圧により生じる画素電極上の液晶分子の配列の均一性の乱れを除去し、表示品質に優れた液晶表示パネルを提供することにある。

【構成】ゲートバスライン上に絶縁物を介してゲートバスラインに平行な別個のバスラインを設け、駆動時にはこのバスラインの電位が一定電位に保たれるシールド電極とする構成とした。また、画素電極を延長し、画素電極が絶縁膜を介して画素電極を挟む両側のゲートバスラインと重なる部分を設けた構成とすることもできる。

本発明の原理説明図



【特許請求の範囲】

【請求項1】 能動素子により各画素の電圧を制御する 能動素子液晶表示パネルにおいて、ゲートパスライン上 に絶縁層を介してゲートバスラインに平行な別個のバス ラインを設け、駆動時にはとのバスラインの電位を一定 電位に保たれることを特徴とする能動素子型液晶表示パ ネル。

【請求項2】 ゲートバスライン上に絶縁膜を介してゲ ートバスラインに平行に設けられた別個のバスライン が、互いに接続されていることを特徴とする請求項1の 10 能動素子型液晶表示パネル

【請求項3】 能動素子により各画素の電圧を制御する 能動素子液晶表示パネルにおいて、画素電極が絶縁膜を 介して画素をはさむ両側のゲートバスラインと重なり部 を有していることを特徴とする能動素子型液晶表示パネ ル

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】 本発明は、パネル全面において 液晶分子をより均一に配向させるための液晶表示パネル 20 の構造、特に電極基板の電極及び配線構成に関する。 [0002]

液晶表示パネルはすでに多くの分野に 【従来の技術】 応用されており、特に画素の電圧を能動素子で制御する 能動素子型(アクティブマトリクス型)液晶表示パネル では、CRT型並みの表示特性が得られるため、携帯テ レビ等が市販されている他、大画面表示パネルが実現さ れつつある。従来のアクティブマトリックス液晶パネル は、マトリックス電極基板、これに対向するITO膜を 全面に形成した共通電極基板、及びこれら電極基板の間 に液晶を封入される液晶材料によって構成されており、 画素電極に電圧を印加することにより表示を行う。

【0003】図6は、従来のアクティブマトリクス液晶 バネルのうち、薄膜トランジスタ(以下「TFT」とい う)液晶パネルにおけるマトリックス電極基板のTFT と画素電極及びバスラインの構成を示す部分平面図であ る。図6において、2はゲートバスライン、3は画素電 極、6はドレインバスラインを示している。画素電極3 の周辺にはゲートバスライン2、ドレインバスライン6 が縦横に形成されている。

【0004】図7はTFTと画素電極との結合部分を示 し、図7(b)におけるA-A'での断面図を図7 (a) に示した。図7(a) において、3は画素電極、 4は絶縁膜、5はガラス基板であり、斜線部分7はゲー トー電極間の電圧により影響を受ける液晶分子の領域を 示している。ゲート電極に電圧が印加されるとトランジ スタのチャネルが開きドレイン側からの信号が画素に書 き込まれる。画素電極への電圧印加時、ゲートバスライ ンには図8のような電圧が印加されるため、ゲートオフ 8において、8はゲート電圧、9はデータ電圧を示して いる。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】 従って、アクティブ マトリクス型液晶表示パネルの場合、ゲートオフ電圧と 画素電極との間の電圧によって画素電極上の液晶分子配 列の均一性に乱れが生じることがある。すなわち、ゲー トバスラインに図8のような電圧が印加されているた め、ゲートオフ電圧Vcorrと画素電極の間に電界が生 じ、この電界の影響でゲートバスライン2と画素電極3 間の液晶配向が乱れる(図8)。かかる画素電極3は図 6に示されるようにマトリックス上に配置されているの で、画素の欠陥となって表示品質の不良を生じる。 [0006]

【課題を解決するための手段】 ゲートバスライン上に 絶縁物を介してゲートバスラインに平行な別個のバスラ インを設け、駆動時にはこのバスラインの電位が一定電 位に保たれるシールド電極とする構成とした。また、画 素電極を延長し、画素電極が絶縁膜を介して画素電極を はさむ両側のゲートバスラインと重なる部分を設けた構 成とするとともできる。

[0007]

【作用】 図1は本発明による作用を説明する図であ る。ゲートバスライン2上に絶縁物4を介してゲートバ スライン2に平行な別個のバスライン1を設け、駆動時 にはこのバスライン 1 の電位が一定電位に保たれるシー ルド電極となっているために、ゲートバスライン2-画 素電極3間に生じていた電界は軽減され、液晶分子の配 向の均一性が保たれることになる。

【0008】また、図2は本発明による他の手段による 作用を説明する図である。図2において、2はゲートバ スライン、3は画素電極、4は絶縁膜、5はガラス基板 を示す。画素電極3を延長し、絶縁膜4を介して画素電 極3を挟む両側のゲートバスライン2との重なり部分を 設けることにより、ゲートバスライン2-画素電極3間 の電界の影響を受ける液晶分子が大幅に減少し、表示域 より距離的に異なった位置に存在することになるから、 少なくとも表示域の液晶分子の配向は均一になり、不均 一な配向に起因して生じていた表示不良をなくすことが 40 できる。 : :::::: -

[0009]

【実施例】図3に本発明の実施例を示す。画素数640 ×400のTFT液晶ディスプレイを作製した。図3に おいて、電極基板はゲートバスライン2、画素電極3、 絶縁膜4、ガラス基板5、ドレインパスライン6から構 成されており、本発明によるバスライン1はゲートバス ライン2 (Ta; 1000A, 幅20μm) 上にSiN 膜4を1500Aの厚さで形成し、その上にTi膜1 を厚さ1000A(幅40μm)で形成した。このTi 電圧と画素電極4との間に電圧が生じることになる。図 50 バスはおのおののバネルの片側の端部において、駆動回 路に接続され、対向する共通電極と同電位とした。作製したパネルにテレビ表示を行ったところ、通常のパネルではパネル全面の画素で画素端部の液晶の配向不良による表示欠陥が生じたのに対し、本発明によるパネルではこのような表示欠陥は一切生じなかった。

【0010】図4に他の実施例を示す。図4(a)には断面図、(b)に平面図を示した。図4(b)の平面図には、Ti膜1のパターンのみを図中に斜線部分で示した。図3と同様にTi膜1を形成するが、この場合、Ti膜1は非画素部で図4(b)のように接続させ、Ti 10膜1で非画素部を埋め尽し非画素部からのもれ光を防ぐブラックマトリックスの作用を兼ねさせるようにしたものである。電位はこの場合も対向する共通電極と同電位にした。このパネルでも、配向不良による表示欠陥は一切生じなかった。

【0011】なお、ゲートバスライン2上に形成したバスライン1の電位は画素電位に近い値に設定すれば良いが、正負の画素電位の中心である、対向電極電位とするのが最も簡単である。図5に本発明の他の実施例を示す。画素数640×400のTFT液晶ディスプレイを 20作製した。図5において、2はゲートバスライン、3は画素電極、4は絶縁膜を示している。画素電極3となる透明電極(ITO)は両側のゲートバスライン(幅15μm)上に各々5μmの重なり部を有している。

【0012】 この場合、ゲートバスライン2と透明電極 3間にはSiN、膜(1500Å)が絶縁膜4として存 在している。作製したパネルにテレビ表示を行ったとこ る、通常のパネルではパネル全面の画素で画素端部で液* *晶の配向不良による表示欠陥が生じたのに対し、本発明 によるパネルではこのような表示欠陥は一切生じなかっ た。これは、通常のパネルではゲートバスラインと画素 電極は10μm隔たっているためである。

[0013]

【発明の効果】本発明によりパネル全面において均一な表示が実現されるため、パネルの表示品質を向上させる ことができる。

【図面の簡単な説明】

- 10 【図1】本発明による原理を説明する図である。
 - 【図2】本発明による原理を説明する図である。
 - 【図3】本発明に係る実施例1を示す図である。
 - 【図4】本発明に係る実施例2を示す図である。
 - 【図5】本発明に係る実施例3を示す図である。
 - 【図6】従来例を示す図である。
 - 【図7】従来例の問題点を説明する図である。
 - 【図8】従来例における印加電圧を示す図である。 【符合の説明】

1 本発明により設けられたバスライン

- 20 2 ゲートバスライン
 - 3 画素電極
 - 4 絶縁膜
 - 5 ガラス基板
 - 6 ドレインパスライン
 - 7 電圧の影響を受ける液晶分子の領域
 - 8 ゲート電圧
 - 9 データ電圧

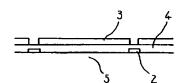
【図1】

【図2】

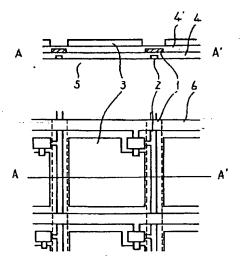
【図3】

本紀明の原理説明図

本発明の原理説明図

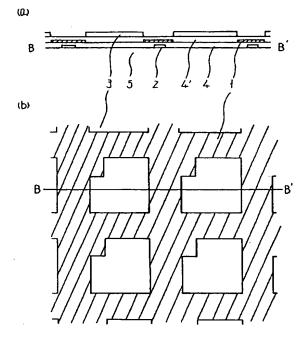


本発明の実施例し



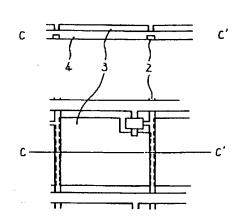
【図4】

太宏明八实施例2



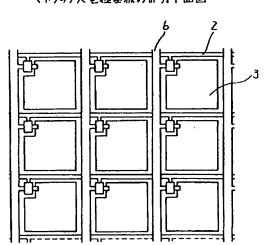
【図5】

本発明の実施例3

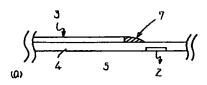


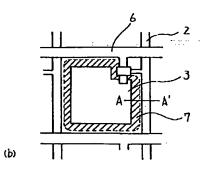
【図6】

アクティブマトリックス液晶パネルにおける マトリックス電極基板の部分平面図

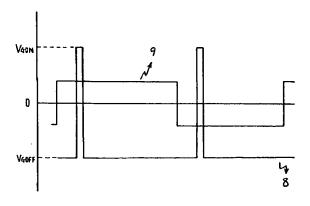


[図7]





【図8】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.⁵ HO1L 27/12 . 29/784 識別記号 庁内整理番号 Α

FΙ

技術表示箇所